2-2-2 高周波電力計の校正 2(1 mW, 75 Ω)

酒井孝次郎 杉山 功 瀬端好一 西山 巌 藤井勝巳

NICT では電波法に基づき高周波電力計の校正を行っているが、入力インピーダンスが 75 Ω の N 型同軸コネクタを入力端子とした高周波電力計のための広帯域 (100 kHz ~ 2 GHz まで) 小電力 (1 mW) 用校正システムを新たに開発した。校正は同時比較法を用いて、その拡張不確かさ (包含 係数 *k*=2) は 10 MHz 未満で 2.5 %、10 MHz 以上で 1.2 % である。

1 まえがき

NICTでは、長年にわたり入力インピーダンス75 Ω のN型同軸コネクタを入力端子とした電力計の校正 業務を、校正電力10 W、周波数1~500 MHzの範 囲で実施してきた。近年、4K・8Kテレビジョン放 送をはじめとして、特性インピーダンス75 Ωの伝送 線路を用いたシステムの使用周波数帯域の高周波化が 進み、電力測定の需要が高まってきていることから、 校正電力1 mW かつ広帯域化(100 kHz~2 GHz)に 対応した入力インピーダンス75 ΩのN型同軸コネク タ入力の小電力電力計校正システムを開発した。

本稿では開発した校正システムの校正方法、特長、 校正結果及び校正の不確かさについて述べる。

2 校正係数の定義

一般に、終端型の高周波電力計は、図1に示すよう にセンサ部と指示部に分かれ、その間を専用ケーブル により接続される構成となっている。電力計の校正で 求めるものは、センサ部に入射する電力 *P*_{in} と電力計 に表示される指示値 *P*_Mの比である校正係数*K*であり、 式 (1) で定義される値である。

$$K = \frac{P_{\rm M}}{P_{\rm in}} \tag{1}$$



図1 高周波電力計の構成

正係数Kは0.99となる。Kが分かっていれば、 P_{M}/K = 0.99/0.99 = 1 mW となり、指示値と校正係数より入射電力を求めることができる。

3 校正方法

3.1 校正の原理

高周波電力計の最も簡易な校正方法として、図2の 構成による比較法がある。この方法は、信号源から出 力された同一の信号を校正係数(K_{STD})が既知の標準電 力計で測定し、指示値(P^{STD})を取得した後、校正係 数(K_{DUT})が未知の被校正電力計に置き換えて測定し、 指示値(P^{DUT})を取得することにより、式(2)のとおり 未知のK_{DUT}を求めることができる。

入射電力=
$$\frac{P_{\rm M}^{\rm STD}}{K_{\rm STD}} = \frac{P_{\rm M}^{\rm DUT}}{K_{\rm DUT}}$$
 $\therefore K_{\rm DUT} = K_{\rm STD} \frac{P_{\rm M}^{\rm DUT}}{P_{\rm M}^{\rm STD}}$ (2)

ただし、式 (2) は図 2 の基準面において反射係数が 0 の理想的な条件の場合であり、実際は電力計の反射 係数 (Γ_{STD} 、 Γ_{DUT})及び信号源の反射係数 (Γ_{G})の影響を 受けるため式 (3) のようになる。

$$K_{\rm DUT} = K_{\rm STD} \left. \frac{P_{\rm M}^{\rm DUT}}{P_{\rm M}^{\rm STD}} \right| \frac{1 - \Gamma_{\rm G} \Gamma_{\rm DUT}}{1 - \Gamma_{\rm G} \Gamma_{\rm STD}} \right|^2 \tag{3}$$

比較法では、特性インピーダンスが同じ同軸コネク タを有する電力計同士を直接比較する必要がある。し かしながら、高周波電力1mWの国家標準は、50 Ω の同軸線路に対してのみ供給され、75 Ωの同軸線路 を用いては供給されていない。そのため、NICT が持 つ国家標準にトレーサブルな標準電力計も入力イン ピーダンスが50 Ωであり、入力インピーダンスが75 Ω のコネクタを有する電力計を校正することはできない。

この問題を解決するために、図3のように被校正電 力計の前段に50Ωと75Ωの特性インピーダンスを変 換する機器(以下「50Ω/75Ω変換器」という。)を挿入



変換器 (50Ω/75Ω変換器)

図 3 インピーダンス変換器 (50 Ω /75 Ω変換器)を使った比較法

して校正を行うことを考えた場合、50 $\Omega/75 \Omega$ 変換器 自体の電気的特性 (S パラメ- p)を別途測定し、補正 する必要がある。また、比較法では、式(3)のとおり 測定が困難な信号源の反射係数 ($\Gamma_{\rm G}$)も求めなければな らない。加えて、標準電力計の測定時と被校正電力計 の測定時の信号源の出力が一定である必要がある。

そこで、新たに開発した校正システムでは信号源の 出力変動が校正結果に影響を与えず、かつ信号源の反 射係数 ($\Gamma_{\rm G}$)の測定が不要な同時比較法 [1] を適用した。

通常、同時比較法においても標準電力計と被校正電 力計は入力インピーダンスが同じである必要があるが、 図4のように50 Ω/75 Ω変換器及びその変換器のロ ス分を補正する固定減衰器をパワー・スプリッタと組 み合わせた構成とすることにより、入力インピーダン ス50 Ωの標準電力計による75 Ωの被校正電力計の 校正を可能とした。

開発した校正システムでは、信号源から出力される 高周波信号は、パワー・スプリッタに入力、分配され る。分配された一方の出力信号は50 Ω/75 Ω変換器 を経由して被校正電力計に入力される。また、他方の 出力信号は固定減衰器を経由して標準電力計に入力さ れる。

3.2 校正手順

校正は制御用 PC (Windows)の校正プログラムにより以下の手順で行われる。

- ① 信号源 (SG) を校正周波数に設定、出力する。
- 彼校正電力計の指示値が1 mW となるよう SG 出力を調整する。
- ③ 標準電力計の指示値と被校正電力計の指示値の 比を設定回数(通常100回)分、測定する。
- ④ 校正周波数ごとに①~③を繰り返す。
- 設定された校正回数(通常5回)分 ①~④を繰り返す。
- ⑧定結果から次式を用いて被校正電力計の校正
 係数 K_{pur} を求める。

$$K_{\text{DUT}} = K_{\text{STD}} \left| \frac{S_{31}}{S_{21}} \right|^2 \left(\frac{P_{\text{M}}^{\text{DUT}}}{P_{\text{M}}^{\text{STD}}} \right) M$$

$$\therefore \vdots \vdots \vdots M \text{ it,}$$
(4)

$$M = \left| \frac{1 - \Gamma_{g2} \Gamma_{DUT}}{1 - \Gamma_{g3} \Gamma_{STD}} \right|^2 \tag{5}$$

また、

$$\Gamma_{g2} = S_{22} - S_{32} \frac{S_{21}}{S_{31}} \tag{6}$$



 $\Gamma_{g3} = S_{33} - S_{23} \frac{S_{31}}{S_{21}}$

(7)

式(4)、(6)、(7)における*S*パラメータは、図4にお けるパワー・スプリッタ、固定減衰器、50 Ω/75 Ω変 換器の入出力面である Port1-3を開口面とした3開口 素子(以下「パワー・スプリッタ」という。)の*S*パラメー タである。このようなインピーダンスが異なる入出力 端子を有するデバイスのSパラメータをベクトル・ ネットワーク・アナライザで測定する場合、測定前の スルー校正において、電気的特性が未知の 50 Ω/75 Ω 変換器を接続して校正を行うことになるが、この変換 器の特性を除去する校正法として「Unknown Through による校正法」[2]があり、この方法による校正を行っ た後にSパラメータの測定を行う。

3.3 国家標準とのトレーサビリティ

本校正に関する国家標準とのトレーサビリティ体系 を図5に示す。標準電力計は、特定二次標準の高周波 電力計により 2-2-1 に示す方法により校正され、反射 係数、Sパラメータを測定するベクトル・ネットワー ク・アナライザは特定二次標準の減衰器により校正さ れることにより、国家標準とのトレーサビリティが確 保されている。

4 特長

開発した校正システムの外観図を図6に示す。本校 正システムの最大の特長は、入力インピーダンス50Ω の標準電力計により75Ωの被校正電力計を校正する 点にあるが、この点以外にシステムを構築する上で考 慮した点、品質の高い校正結果を得るための校正技術 及び性能を維持するために必要な保守項目について述 べる。

(1) 作業性、保守性を考慮し、図6のとおり被校正 電力計を含め19インチ小型(13U)ラックに収



図5 トレーサビリティ体系



図6 高周波電力計校正システム (1 mW, 75 Ω) 外観図

2 較正技術の研究開発

容し、省スペース化を図った。

- (2)標準電力計及び被校正電力計の接続面(図4の Port2、3)は、電力計のセンサ部分の自重によ る接続面への影響を均一化するため、図6のと おりセンサ部分を垂直に接続する配置とした。
- (3) 被校正電力計のセンサ部分のコネクタの接続に よるばらつきを評価するため、5回の校正の各 回終了後、360度を5分割した約72度センサ 部分を回転させて再接続し測定する。ただし、 回転させる時はコネクタ接続面の摩耗劣化を防 ぐため、確実にコネクタを取り外してから回転



図7 N型同軸コネクタの形状

させ、再接続する必要がある。

- (4) コネクタの接続には、トルク・レンチを使用し 規定のトルクで締め付けることにより、測定の 再現性を確保する。
- (5)標準電力計(50 Ω)及び被校正電力計(75 Ω)の 接続面は、図7のとおり両者ともN型同軸コ ネクタであり、その形状は中心導体の径の大き さ(図7の矢印部分)以外は同一寸法であり、 非常に見分けづらい。仮に、図4のPort2 (75 Ω メス)に標準電力計センサ(50 Ω オス)を 間違って接続した場合、中心導体の径の違いに より、Port2(75 Ω メス)の中心導体を破損させ ることになる。この誤接続を防止するため、 Port2の接続面脇に接続しようとしているコネ クタが「75 ΩN型コネクタ」であることを再確 認させるため注意書を記載している。

(6) 保守項目

- (a)本校正システムの正常性確認のため1年に 1回、妥当性確認用被校正電力計の校正を行い、システムが正常に動作することを確認するとともに校正結果の経年変化、妥当性を チェックする。
- (b) トレーサビリティ確認のため半年に1回、ベクトル・ネットワーク・アナライザで高周波減衰器(特定二次標準器)の減衰量を測定し、上位校正値と比較することにより経年変化、妥当性を確認する。また、このベクトル・ネットワーク・アナライザでパワー・スプリッタ



図8 パワー・スプリッタのSパラメータ測定結果の例

のSパラメータを測定し、経年変化、妥当性 をチェックする。Sパラメータ測定結果の例 を図 8 に示す。 S_{21} と S_{31} の差分(約 0.2 dB)は、 固定減衰器と 50 Ω /75 Ω 変換器の減衰量の 差であるが、この差は式(4)の $|S_{31}/S_{21}|^2$ によ り補正されるため、校正結果に影響を与える ものではない。

5 校正結果

開発した校正システムを用いて、入力インピーダン ス75Ωのセンサ部(キーサイト・テクノロジー社製: 8483 A)と指示部(同社製: E4418 B)を被校正電力計 として校正を行った。

図9に校正結果の例を示す。実線(●)が今回開発 した校正システムによる校正結果、破線(▲)がキー サイト・テクノロジー社による校正係数であり、これ



図 10 不確かさの比較

は米国の国家標準機関である NIST (National Institute of Standards and Technology) にトレーサブルな校正 係数である。両者は全周波数において、次に述べる不 確かさの範囲内でよく一致しており、良好な校正結果 と考えられる。

6 校正の不確かさ

開発した校正システムによる校正結果に付随する不確かさ *u*(*K*_{DUT})は、不確かさの伝播則より次式となる [3]。

$$\frac{u(K_{\text{DUT}})}{K_{\text{DUT}}} = \sqrt{\left(+1\right)^{2} \left\{\frac{u(K_{\text{STD}})}{K_{\text{STD}}}\right\}^{2} + \left(+2\right)^{2} \left\{\frac{u(S_{31})}{|S_{31}|}\right\}^{2} + \left(-2\right)^{2} \left\{\frac{u(S_{21})}{|S_{21}|}\right\}^{2}}{+ \left(+1\right)^{2} \left\{\frac{u(P_{\text{M}}^{\text{DUT}})}{P_{\text{M}}^{\text{DUT}}}\right\}^{2} + \left(-1\right)^{2} \left\{\frac{u(P_{\text{M}}^{\text{STD}})}{P_{\text{M}}^{\text{STD}}}\right\}^{2} + \left(+1\right)^{2} \left\{\frac{u(M)}{M}\right\}^{2}} \quad (8)$$

不確かさの各要因は、式(8)右辺第1項より順に① 標準電力計の校正不確かさ、②パワー・スプリッタ Port1-3間の減衰量(Sパラメータ)の不確かさ、③パ ワー・スプリッタ Port1-2間の減衰量(Sパラメータ) の不確かさ、④被校正電力計の測定分解能、⑤標準電 力計の測定分解能、⑥標準電力計とパワー・スプリッ タ及び被校正電力計とパワー・スプリッタ間の不整合、 ⑦測定のばらつきがある。ただし、式(8)右辺の中括 弧の直前の括弧内の値は、各要因に対する感度係数 c(x)を表す。

①については、上位校正の不確かさを用いる(正規 分布)。②③については、国家標準にトレーサブルな 仲介高周波減衰器により校正されたベクトル・ネット ワーク・アナライザで測定した時の不確かさを用いる (正規分布)。④⑤は標準電力計及び被校正電力計の表 示桁から決定する(一様分布)。⑥は標準電力計及び 被校正電力計の反射係数とパワー・スプリッタのSパ ラメータを実測算出する(U分布)。⑦は測定を5回 繰り返し行い、ばらつきを求める(正規分布)。

図10に不確かさの比較結果を示す。キーサイト・ テクノロジー社による校正の不確かさと比較して 10 MHz 未満で不確かさが大きいのは上位校正の不確 かさが大きいことに起因している。また、10 MHz 以 上ではキーサイト・テクノロジー社の不確かさと同等 もしくは 0.1 % 小さいことから、システムとして校正 業務に十分な性能を有すると判断される。

表1、2に校正不確かさの算出例を示す。表1は不 確かさが最大である周波数100kHz、表2は最高周波 数2GHzの校正不確かさのバジェットである。表1 において、不確かさを大きくしている主な要因として 標準電力計の校正不確かさu(K_{STD})であることが分か るが、上位校正機関 (産業技術総合研究所) における 校正結果に付随する不確かさであるため自ら改善する ことは難しい。それ以外では、のSパラメータの不確 かさ $u(|S_{31}|)$ 及び $u(|S_{21}|)$ が要因となっている。今後は、 この減衰量測定の不確かさを小さくする方法を検討す る。

7 あとがき

周波数範囲が 100 kHz~2 GHz において、入力イ ンピーダンスが 75 Ωの N 型同軸コネクタ入力の小電 力 (1 mW) 電力計校正システムを開発し、実際に校正 を行い校正システムが持つ校正の不確かさを求めた。 10 MHz 未満で 2.5 %、10 MHz 以上で 1.2 % の拡張不 確かさで電力計の校正が可能であることが分かった。

今後の課題としては、パワー・スプリッタの*S*パラ メータの不確かさを小さくする方法の検討を含めた校 正品質の維持・向上である。

【付録】 式(4)の導出

図4に示す同時比較法の校正システムにおいて、 Port1に信号源、Port2に被校正電力計、Port3に標 準電力計が接続された状態を、Sパラメータを用いて 表すと、次式が得られる。

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{23} & S_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$
(A.1)

$$a_1 = a_G + \Gamma_G b_1 \tag{A.2}$$

$$a_2 = \Gamma_{\rm DUT} b_2 \tag{A.3}$$

$$a_3 = \Gamma_{\text{STD}} b_3 \tag{A.4}$$

ただし、S行列はパワー・スプリッタを含む点線で示 した 3 Port 回路の特性を表しており、 a_G は信号源の 出射波、 Γ_G は信号源の反射係数、 Γ_{DUT} は被校正電力 計の反射係数、 Γ_{STD} は標準電力計の反射係数である。

これらの式から、被校正電力計に入射する電力P^{DUT}及び標準電力計に入射する電力P^{STD}を求めると、それぞれ、

$$P_{\rm in}^{\rm DUT} = \left| b_2 \right|^2 = \left| \frac{D_{(2S1)(11)}}{D} \right|^2 \left| a_G \right|^2 \tag{A.5}$$

$$P_{\rm in}^{\rm STD} = \left| b_3 \right|^2 = \left| \frac{D_{(3S1)(11)}}{D} \right|^2 \left| a_G \right|^2 \tag{A.6}$$

不確かさの要因		不確かさ	分布	除数	標準不確 かさ u(x)	感度 係数 c(x)	不確かさへの寄与 c(x) u(x)
$K_{ m STD}$	標準器	2.20 % (k=2)	正規	2	1.10 %	1	1.10 %
S_{31}	減衰量	$0.015~\mathrm{dB}$	正規	1	0.17~%	2	0.35~%
S_{21}		$0.015~\mathrm{dB}$	正規	1	0.17~%	-2	0.35~%
$P_{\mathrm{M}}^{\mathrm{DUT}}$	電力計	0.05~%	一様	$\sqrt{3}$	0.03~%	1	0.03 %
$P_{ m M}^{ m STD}$	万mm 4桁	0.05~%	一様	$\sqrt{3}$	0.03~%	-1	0.03 %
M	不整合	0.06 %	U	$\sqrt{2}$	0.04 %	1	0.04 %
s(K _{DUT})	再現性	0.09 %	正規	$\sqrt{5}$	0.04 %	1	0.04 %
	1.21 %						
	$2.5 \ \%$						

表 1 不確かさバジェットの例 (100 kHz, 1 mW)

表 2 不確かさバジェットの例 (2 GHz, 1 mW)

不確かさの要因		不確かさ	分布	除数	標準不確 かさ u(x)	感度 係数 c(x)	不確かさへの寄与 c(x) u(x)
$K_{ m STD}$	標準器	0.46 % (<i>k</i> =2)	正規	2	0.23~%	1	0.23~%
S_{31}	減衰量	$0.015~\mathrm{dB}$	正規	1	0.17~%	2	0.35~%
S_{21}		$0.015~\mathrm{dB}$	正規	1	0.17~%	-2	0.35~%
$P_{\mathrm{M}}^{\mathrm{DUT}}$	電力計 公報能	0.05~%	一様	$\sqrt{3}$	0.03~%	1	0.03 %
$P_{\mathrm{M}}^{\mathrm{STD}}$	万 _胜 拒 4 桁	0.05~%	一様	$\sqrt{3}$	0.03~%	-1	0.03 %
M	不整合	0.07~%	U	$\sqrt{2}$	0.05~%	1	0.05~%
$s(K_{\rm DUT})$	再現性	0.11 %	正規	$\sqrt{5}$	0.05~%	1	0.05~%
	0.55~%						
	1.1 %						

$$\mathcal{T}_{2}\mathcal{T}_{2}\mathcal{T}_{2}\mathcal{T}_{3}$$

$$D = \det \begin{bmatrix} 1 - S_{11}\Gamma_{G} & -S_{12}\Gamma_{DUT} & -S_{13}\Gamma_{STD} \\ -S_{21}\Gamma_{G} & 1 - S_{22}\Gamma_{DUT} & -S_{23}\Gamma_{STD} \\ -S_{31}\Gamma_{G} & -S_{32}\Gamma_{DUT} & 1 - S_{33}\Gamma_{STD} \end{bmatrix}$$
(A.7)

$$D_{(2S1)(11)} = \det \begin{bmatrix} S_{21} & -S_{23}\Gamma_{\text{STD}} \\ S_{31} & 1-S_{33}\Gamma_{\text{STD}} \end{bmatrix} = S_{21} \left\{ 1 - \left(S_{33} - S_{23}\frac{S_{31}}{S_{21}} \right) \Gamma_{\text{STD}} \right\}$$
(A.8)

$$D_{(3S1)(11)} = \det \begin{bmatrix} 1 - S_{22}\Gamma_{DUT} & S_{21} \\ -S_{32}\Gamma_{DUT} & S_{31} \end{bmatrix} = S_{31} \left\{ 1 - \left(S_{22} - S_{32}\frac{S_{21}}{S_{31}} \right) \Gamma_{DUT} \right\}$$
(A.9)

である。ここで、 det[A] は、行列 A の行列式を表す。 いま、2 つの入射電力を同時に測定して比を求める と、式 (A.5)、(A.6) より、

$$\frac{P_{\rm M}^{\rm DUT}}{P_{\rm M}^{\rm STD}} = \frac{K_{\rm DUT}}{K_{\rm STD}} \frac{P_{\rm in}^{\rm DUT}}{P_{\rm in}^{\rm STD}} = \frac{K_{\rm DUT}}{K_{\rm STD}} \left| \frac{D_{(2S1)(11)}}{D_{(3S1)(11)}} \right|^2 = \frac{K_{\rm DUT}}{K_{\rm STD}} \left| \frac{S_{21}}{S_{31}} \right|^2 \frac{1 - \left(S_{33} - S_{23} \frac{S_{31}}{S_{21}} \right) \Gamma_{\rm STD}}{1 - \left(S_{22} - S_{32} \frac{S_{21}}{S_{31}} \right) \Gamma_{\rm DUT}} \right|^2$$

(A.10)

を得る。ここで、 $P_{in}^{DUT} = P_{M}^{DUT}/K_{DUT}$ 及び $P_{in}^{STD} = P_{M}^{STD}/K_{STD}$ の関係を用いた。式変形すれば、以下のとおり、式(4)が得られる。

$$K_{\rm DUT} = K_{\rm STD} \left| \frac{S_{31}}{S_{21}} \right|^2 \left(\frac{P_{\rm M}^{\rm DUT}}{P_{\rm M}^{\rm STD}} \right) \frac{1 - \left(S_{22} - S_{32} \frac{S_{21}}{S_{31}} \right) \Gamma_{\rm DUT}}{1 - \left(S_{33} - S_{23} \frac{S_{31}}{S_{21}} \right) \Gamma_{\rm STD}} \right|^2$$
(A.11)

式の導出過程において、式(A.7)で示した行列式D は消去されるため、実際に求める必要はない。このこ

2 較正技術の研究開発

とは、信号源の反射係数 $(\Gamma_{\rm G})$ が未知でよいことを意味しており、同時比較法の大きな特長である。

【参考文献】

- 1 島岡一博, "高周波電力計の比較校正方法におけるモデル式の理論解説," 第 17回高周波クラブ会合, 産業技術総合研究所計量標準総合センター, Feb. 2014
- 2 岩崎俊, "電磁波計測 ―ネットワークアナライザとアンテナ―," コロナ 社, Oct. 2007
 4. Oct. 2007
- 3 飯塚幸三 監修, "計測における不確かさの表現ガイド,"日本規格協会, Nov. 1996.



酒井孝次郎 (さかい こうじろう) 電磁波研究所 電磁環境研究室 有期研究技術員 無線用測定器の較正



杉山 功 (すぎやま つとむ)
 電磁波研究所
 電磁環境研究室
 主任研究員
 無線用測定器の較正



瀬端好― (せばた こういち) 電磁波研究所 電磁環境研究室 主任研究員 無線用測定器の較正、測地学



西山 巌 (にしやま いわお) 電磁波研究所 電磁環境研究室 無線用測定器の較正



藤井勝巳 (ふじい かつみ) 電磁波研究所 電磁環境研究室 研究マネージャー 博士 (工学) 無線用測定器の較正、環境電磁工学